# 现代电子技术与系统

华东理工大学自动化系

刘笛(徐汇校区实验十九楼1005)

Tel: 18939810219 Email: liudi@ecust.edu.cn

# 电子技术

电子技术:根据电子学的原理,应用电子器件设计和制造某种特定功能的电子电路,通过对电子信号的处理来解决实际问题的一门技术



# 电子技术的发展

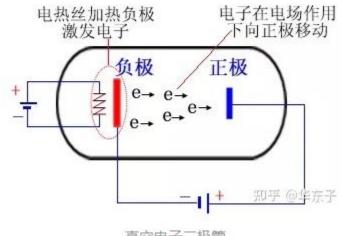
- 1883年,美国著名发明家爱迪生,发现了热电子效应-爱迪生效应,这是一种通过热激发发射载流子的现象。原理是:提供给载流子的热能使它们能够克服束缚位能(在金属材料中,这束缚位能也被称为功函数或逸出功)。通过热发射产生的载流子可能是电子或者离子。产生电子的热发射被称为热电子发射。
- 1904年,英国电机工程师、物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明(John Ambrose Fleming)利用热电子效应制成了电子管(二极管),并证实了电子管具有"阀门"作用,它首先被用于无线电检波。

# 电子技术的发展

• 1904年,英国电机工程师、物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明(John Ambrose Fleming)利用热电子效应制成了电子管(二极管),并证实了电子管具有 "阀门"作用,它首先被用于无线电检波。



#### 电子二极管原理



真空电子二极管

# 电子技术的发展

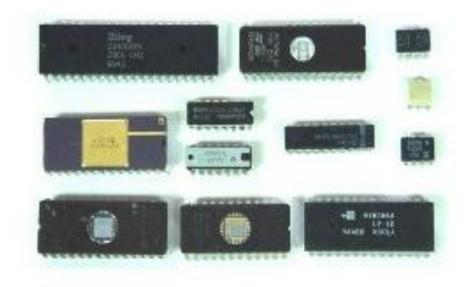
- 1906年,美国的德弗雷斯在弗莱明的二极管中放进了第三个电极一栅极,发明了电子三极管,这是早期电子技术上最重要的里程碑。1904年,英国电机工程师、物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明(John Ambrose Fleming)利用热电子效应制成了电子管(二极管),并证实了电子管具有"阀门"作用,它首先被用于无线电检波。
- 1911年开始,随着电子管技术进步与推广应用,电子技术开始发展起来。电子管的缺点是成本高,制造繁,体积大,耗电多。
- 1929年,已经取得一种晶体管的专利。但是,限于当时的技术水平,制造这种器件的材料达不到足够的纯度,这种晶体管无法制造出来。

# 电子技术的发展

- 1947年12月16日,美国贝尔实验室研制出一种点接触型的锗晶体管。在为这种器件命名时,布拉顿想到它的电阻变换特性,即它是靠一种从"低电阻输入"到"高电阻输出"的转移电流来工作的,于是取名为trans-resister(转换电阻),后来缩写为transister,中文译名就是晶体管,也称为"半导体器件"或"固体器件"。
- 1950年,第一只"面结型晶体管"问世了,它的性能与肖克莱原来设想的完全一致。今天的晶体管,大部分仍是这种面结型晶体管。
- 1951年,有了商品,这是出现分立元件的又一个里程碑。

# 电子技术的发展

 1958年,在德州仪器公司的实验室里,实现了把电子器件集成在一块半导体 材料上的构想。第一片集成电路只有4个晶体管。集成电路的出现和应用, 标志着电子技术发展到了一个新的阶段。



# 电子技术的发展

- 1960年,集成电路处于"小规模集成"阶段,每个半导体芯片上有不到100个元器件。
- 1966年, 进入"中规模集成"阶段, 每个芯片上有100到1000个元器件。
- 1969年, 进入"大规模集成"阶段, 每个芯片上的元器件达到10000左右。
- 1975年, 跨入"超大规模集成"阶段, 每个芯片上的元器件多达10000个以上, 已经进入"微电子"时代。
- 从1960年至1980年的二十年间,芯片上元器件的"集成度"增加了1000000倍, 每年递增率约为2倍。

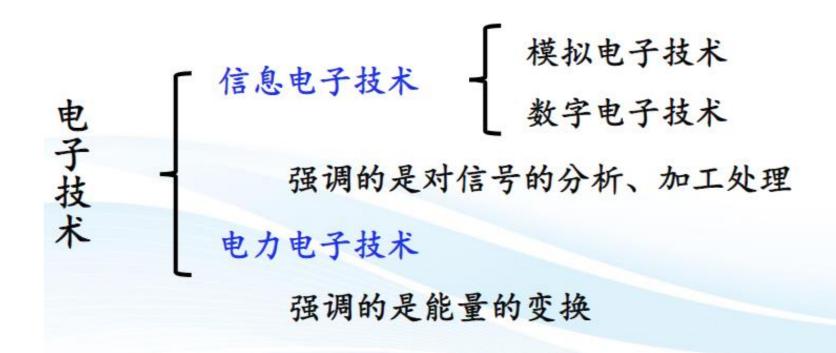
# 电子技术的发展

摩尔定律:多年以来,电子制造技术的发展都遵循摩尔定律。即当芯片价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目约每隔18-24个月便会增加一倍,技术性能也随之提升一倍。

随着集成电路集成度进一步提升,从芯片的制造来看,7nm是物理极限。一旦晶体管大小低于这一数字,它们在物理形态上就会非常集中,以至于产生量子隧穿效应,为芯片制造带来巨大挑战。

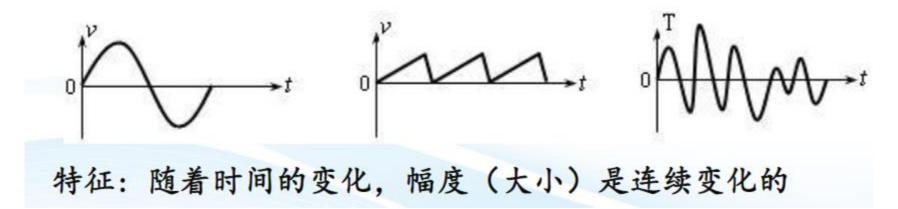
#### 摩尔定律还准吗?

# 信息电子技术与电力电子技术



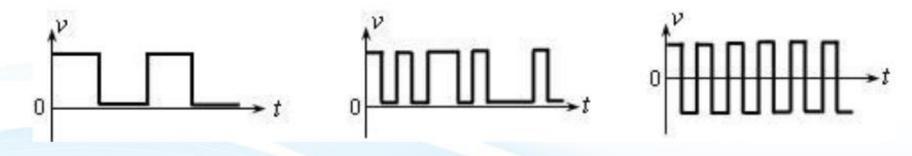
# 模拟信号与数字信号

◆ 模拟信号是时间上和数值上都连续的信号



# 模拟信号与数字信号

◆ 数字信号在时间上和数值上都是离散的、不连续的 每一次的增减变化都是某个最小量的整数倍



特征: 幅度(大小)随时间变化是不连续的,是断续的

# 模拟电子技术与数字电子技术

模拟电子技术:分析、处理 连续的电信号

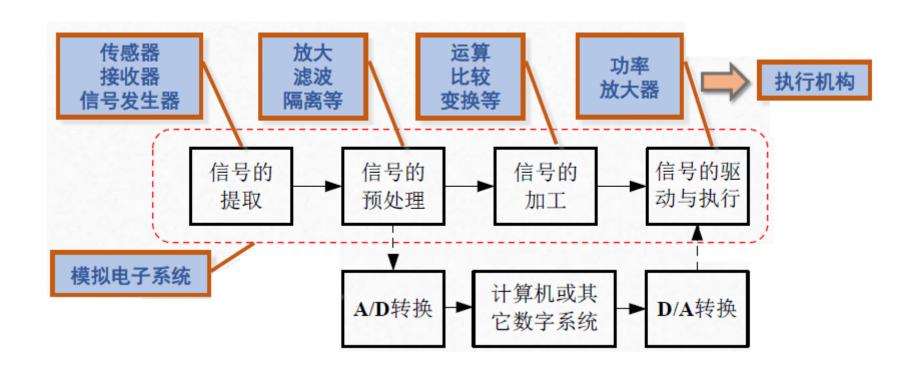
如:讲话的音频信号;电视图象信号;温度、流量、压力变换 而成的电信号等

数字电子技术:分析、处理 不连续(离散)的电信号如:雷达信号、电报信号、电视信号中的同步信号、脉冲信号等

◆分析和设计的方法以及所用的数学工具都有显著不同

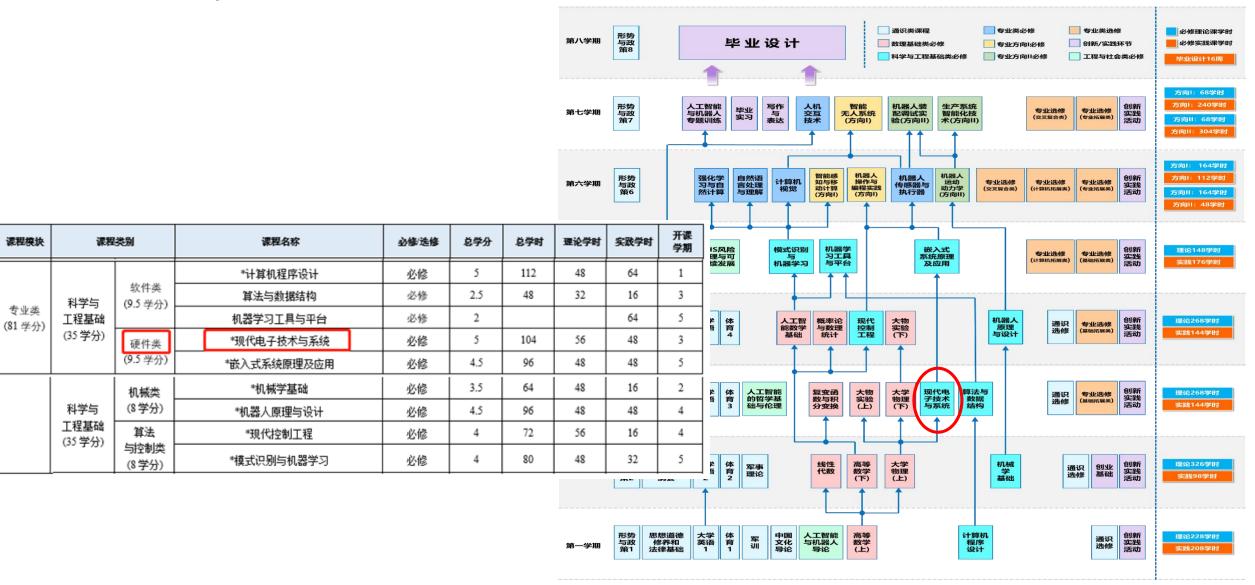
# 电子系统

所谓电子系统,就是由若干个相互关联、相互作用的基本电子 电路组成的电路整体称为**电子系统**。

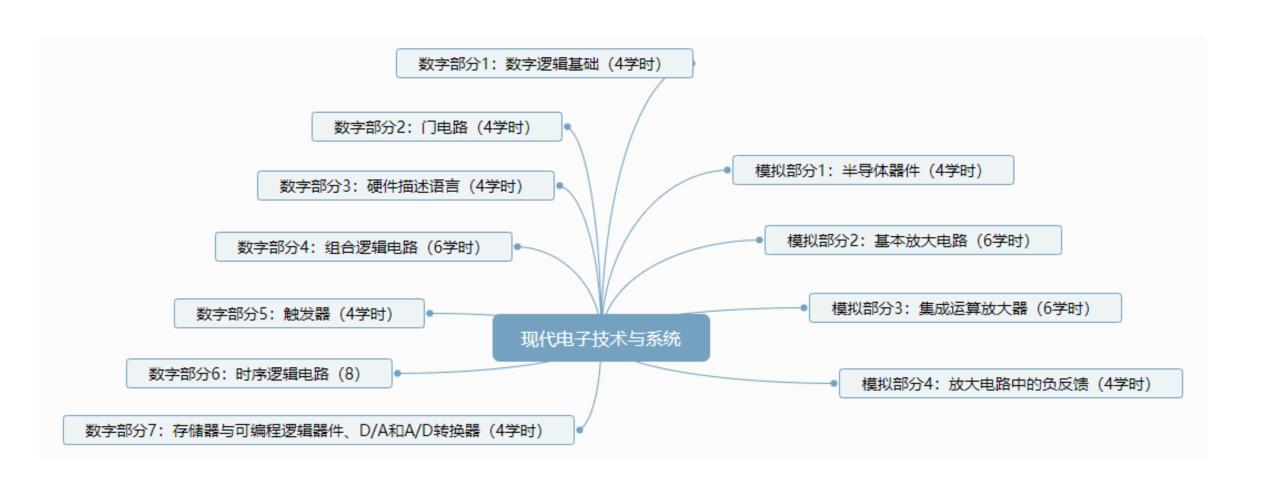


# 课程性质

#### 电子技术与电子系统 课程介绍



# 课程内容



# 课程目标

能熟练地运 用基础知识 和理论对各 类电路进行 分析

掌握数字系统硬件分析, 设计和开发的基本技能

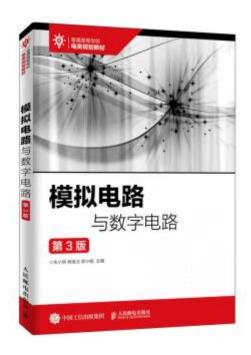
熟悉典型的 放大电路与 数字电路的 组成与特点 能根据应用 需求用合适 的集成电路 芯片完成各 种逻辑部件 的设计

# 重视实践环节

# 课程特点与学习方法

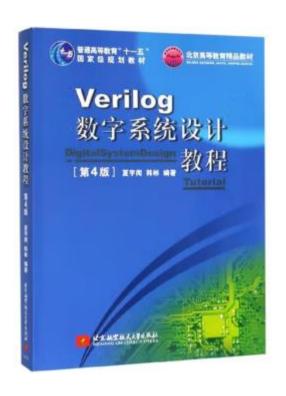


# 使用教材



朱小明等. 模拟电路与数字电路(第3版). 人民邮电出版社

#### 电子技术与电子系统 课程介绍



夏宇闻. Verilog数字系统设计教程(第4版). 北京航天大学出版社

# 课程考核

理论学时

56学时

实践学时

48学时

考核方式

40%平时成绩+60%闭卷笔试

平时成绩

50%作业+50%实验

#### 晶体管的发明

- ●1947年12月16日贝尔实验室晶体管小组成员Brattain观察到流经两根导线间锗晶体的电流被放大,奠定了晶体管的发明
- ●发明晶体管是三位科学家长期合作的结果:
  - ·John Bardeen(理论物理学家,曾作为低温超导理论的创始人获1972年诺贝尔物理学奖)提出了表面态理论
  - •Walter H Brattain(天才的实验家,博士,在贝尔实验室工作了33年)设计了晶体管放大器实验
  - •Willian Shockley(博士,才华横溢的领导者,发明了结型晶体管,他支持创建了Intel公司)给出了实现放大器的基本设想
- ➤晶体管的发明,宣布了信息时代的到来,这三位晶体管之父,因此获**1956**年诺贝尔物理学奖

- ●1950年,结型晶体管诞生
- ●1950年, R 0hl和肖特莱发明了离子注入工艺
- ●1951年,场效应晶体管发明
- ●1956年, CS Fuller发明了扩散工艺
- ●1958年,仙童公司Robert Noyce与德仪公司基尔比间隔数月分别发明了 集成电路,开创了世界微电子学的历史
- ●1960年, H H Loor和E Castellani发明了光刻工艺
- ●1962年,美国RCA公司研制出MOS场效应晶体管
- ●1963年, F. M. Wanlass和C. T. Sah首次提出CMOS技术, 今天, 95%以上的 集成电路芯片都是基于CMOS工艺
- ●1964年, Intel摩尔提出摩尔定律, 预测晶体管集成度将会每18个月增加1倍
- ●1966年,美国RCA公司研制出CMOS集成电路,并研制出第一块门阵列 (50门)
- ●1971年, Intel推出1kb动态随机存储器(DRAM), 标志着大规模集成电路出现

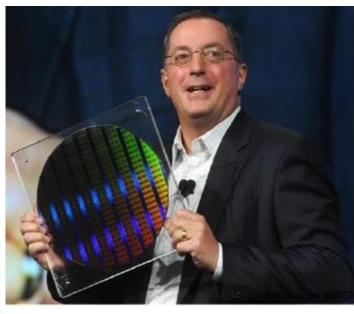
- ●1971年,全球第一个微处理器4004由Intel公司推出,采用的是MOS工艺, 这是一个里程碑式的发明
- ●1974年, RCA公司推出第一个CMOS微处理器1802
- ●1976年, 16kb DRAM和4kb SRAM问世
- ●1978年,64kb动态随机存储器诞生,不足0.5平方厘米的硅片上集成了14 万个晶体管,标志着超大规模集成电路(VLSI)时代的来临
- ●1979年, Intel推出5MHz 8088微处理器, IBM基于8088推出全球第一台PC
- ●1981年, 256kb DRAM和64kb CMOS SRAM问世
- ●1984年,日本宣布推出1Mb DRAM和256kb SRAM
- ●1988年, 16M DRAM问世, 1平方厘米大小的硅片上集成有3500万个晶体管, 标志着进入VLSI阶段
- ●1989年, 1Mb DRAM进入市场
- ●1989年,486微处理器推出,25MHz,1 μm工艺,后来50MHz芯片采用 0.8 μm工艺

- ●1992年,64M位随机存储器问世
- ●1993年, 66MHz奔腾处理器推出, 采用0.6 µ m 工艺
- ●1995年, Pentium Pro, 133MHz, 采用0.6-0.35 µ m 工艺
- ●1997年, 300MHz奔腾 II 问世, 采用0. 25 μ m 工艺
- ●1999年,奔腾Ⅲ问世,450MHz,采用0.25 μ m 工艺,后采用0.18 μ m 工艺
- ●2000年, 1Gb RAM投放市场
- ●2000年, 奔腾4问世, 1.5GHz, 采用0.18 µ m 工艺
- ●2001年, Intel宣布2001年下半年采用0.13 μ m 工艺
- ●2003年,奔腾4 E系列推出,采用90nm工艺
- ●2005年, intel 酷睿2系列上市, 采用65nm工艺
- ●2007年,基于全新45nm工艺的intel酷睿2 E7/E8/E9上市
- ●2009年, intel酷睿i系列全新推出, 创纪录采用了领先的32mm工艺,

- ●1992年,64M位随机存储器问世
- ●1993年, 66MHz奔腾处理器推出, 采用0.6 µ m 工艺
- ●1995年, Pentium Pro, 133MHz, 采用0.6-0.35 µ m 工艺
- ●1997年, 300MHz奔腾 II 问世, 采用0. 25 μ m 工艺
- ●1999年,奔腾Ⅲ问世,450MHz,采用0.25 μ m 工艺,后采用0.18 μ m 工艺
- ●2000年, 1Gb RAM投放市场
- ●2000年, 奔腾4问世, 1.5GHz, 采用0.18 µ m 工艺
- ●2001年, Intel宣布2001年下半年采用0.13 μ m 工艺
- ●2003年,奔腾4 E系列推出,采用90nm工艺
- ●2005年, intel 酷睿2系列上市, 采用65nm工艺
- ●2007年,基于全新45nm工艺的intel酷睿2 E7/E8/E9上市
- ●2009年, intel酷睿i系列全新推出, 创纪录采用了领先的32mm工艺,

- ●2009年9月底,在旧金山秋季IDF 2009论坛上,Intel第一次向世人展示了22nm工艺晶圆,并宣布将在2011年下半年发布相关产品
- ●每台22nm光刻工艺设备最低为3000万美元





Intel总裁兼CEO Paul Otellini展示 22nm晶圆

- ●Intel2012年推出22nm工艺,骄傲地指出,22nm技术将继续延续摩尔定律之路
- ●2013年、展示了14nm Broadwell CPU

## 历史发展: CPU

#### 以Intel公司的CPU为例:

1971年, Intel公司生产出世界上第一个微处理器——4004

●面积: 4mm×3mm

●集成度: 共2300个晶体管

●工作频率: 108KHz

●工艺制程: 10um

●总线宽度: 4bits

●存储容量: 640bytes

意义重大:为以后"使用通用的硬件设计作为基础,用软件来实现不同的功能"这一设计思想开辟了道路

4004微处理器的发明人Ted Hoff因此被英国《经济学家》杂志列为"第二次世界大战以来最有影响的七位科学家之一"

### 历史发展: CPU

- ●1972年和1974年, Intel公司研制出8080和8085处理器, 它们是8位微 处理器
- ●1978年, Intel公司生产出16位的微处理器, 并命名为8086
- ●1985年, Intel公司推出80386, 这是一种32位微处理器芯片, 内部包含了27.5万个晶体管, 时钟频率为12.5MHz, 后逐步提高到33MHz
- ●1993年InteI推出了全新一代的高性能处理器∞∞奔腾
- ●1996年推出了最新一代的第六代X86系列CPU∞∞奔腾Pro
- ●1997年5月, 推出Pentium II 处理器
- ●1998年,为了占领低端市场,推出Celeron处理器
- ●1998与1999年间,在高端的、基于RISC的工作站和服务器上,Intel 公司推出了新一款Pentium || Xeon
- ●1999年初,推出了新一代处理器Pentium III
- ●2000年, Intel公司发布集成4200万个晶体管的Pentium 4处理器
- ●2006年,英特尔-酷睿2双核处理器,随后的四核以及八核

## 历史发展: CPU

2008年11月, Intel发布了最新的Core i7台式机处理器目前最豪华的台式机处理器——Core i7 980x(至尊版)处理器:

●面积: 248mm<sub>2</sub>

●集成度:共11.7亿个晶体管

●工作频率: 3.33GHz

●工艺制程: 32nm

●总线宽度: 64bits

●最大内存: 24GB



1、摩尔定律

集成电路的发展规律:摩尔定律(Moore Law)

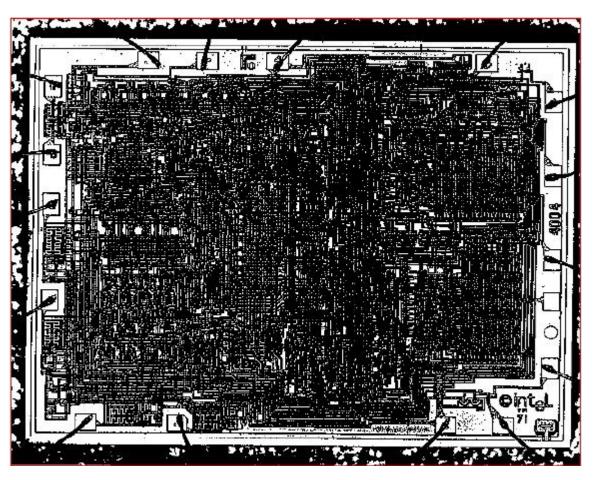
--- Min. transistor feature size decreases by 0.7X every three years

--- True for at least 30 years! (first published in 1965)

后人对摩尔定律加以扩展:

集成电路的发展:工艺每三年升级一代,集成 度每三年翻两番,特征线宽约缩小30%左右,逻辑电路(以CPU为代表)的工作频率提高约30%

■ 以Intel的微处理器为例,说明集成电路的发展符合Moore 定律



第一个CPU: 4004

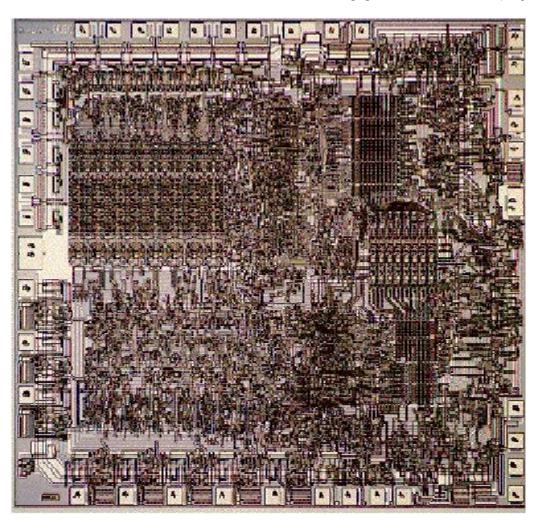
时间: 1971年

工艺: NMOS

晶体管个数: 2300

频率: 108KHz

Moore定律(CPU的发展)



Intel 8080 CPU

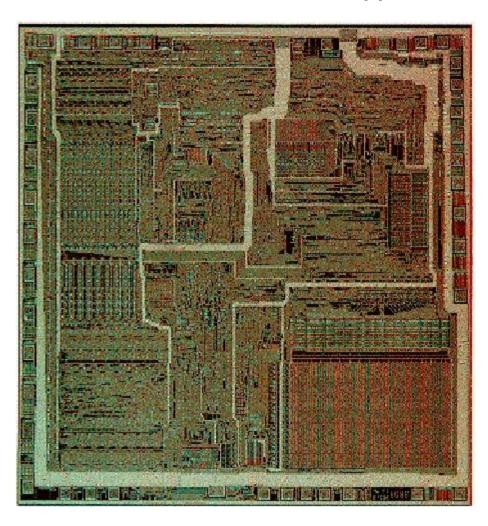
第一块8位微处

理器

时间: 1974

晶体管数: 8000

Moore定律(CPU的发展)

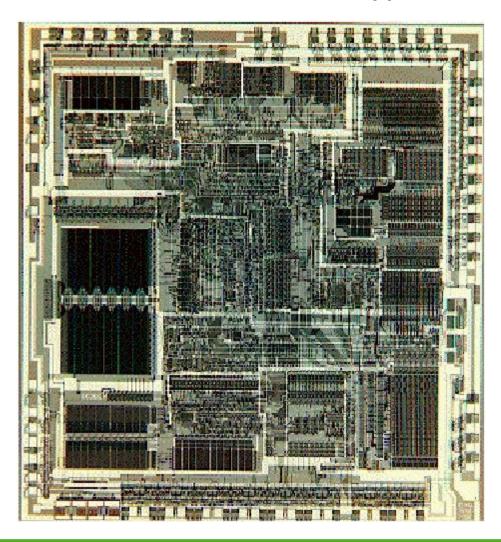


Intel 8086 CPU 1978年

IBM PC的心脏

晶体管数: 29000

Moore定律(CPU的发展)



Intel 80286 CPU

1982年

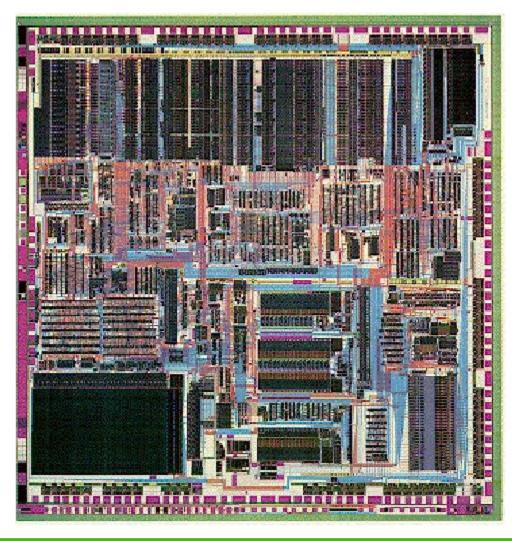
晶体管数:

120000

时钟频率:

10/12.5MHz

Moore定律(CPU的发展)



Intel 80386 CPU

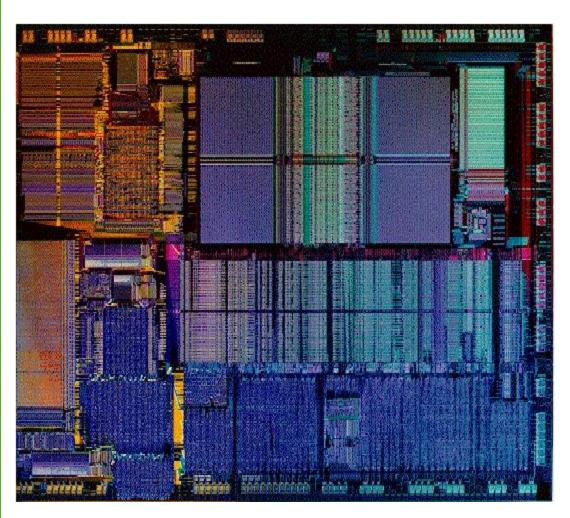
发布时间: 1985

工艺: HNMOS

晶体管数: 27.5万

时钟频率: 20~40

#### Moore定律(CPU的发展)



Intel 80486 CPU

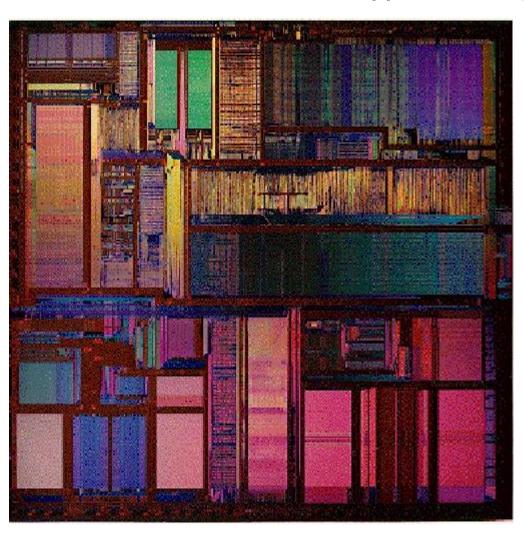
时间: 1989

工艺: BiCMOS

晶体管数: 118万

时钟频率:33~

#### Moore定律(CPU的发展)



Intel Pentium CPU

发布日期: 1992年10月

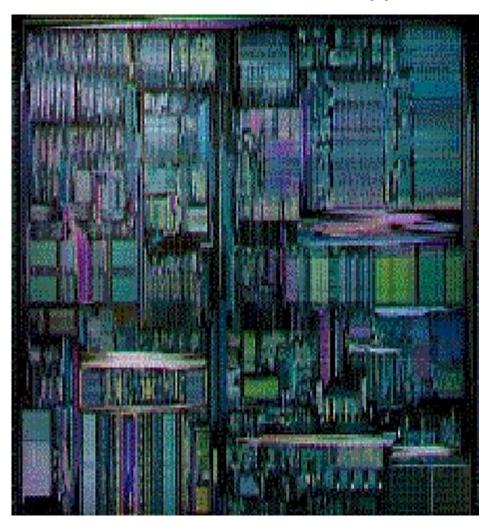
工艺: 0.8um BiCMOS

晶体管数: 310万

时钟频率: 66/60~

120Mhz

#### Moore定律(CPU的发展)



Intel Pentium Pro CPU

发布日期: 1995年11月

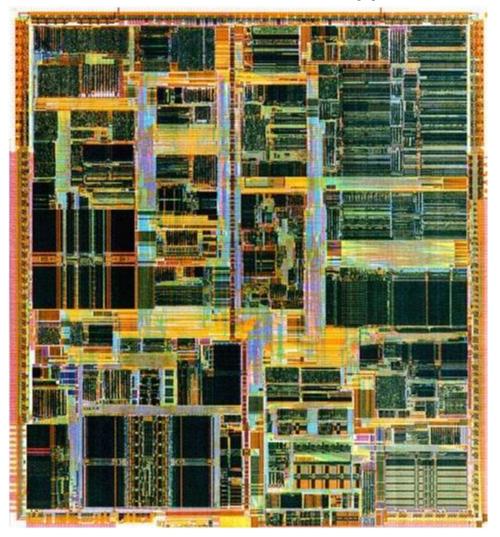
工艺: 0.6/0.35um

**CMOS** 

晶体管数:550万

时钟频率: 150 ~ 200

#### Moore定律(CPU的发展)



Intel Pentium II CPU

发布日期: 1997年5月

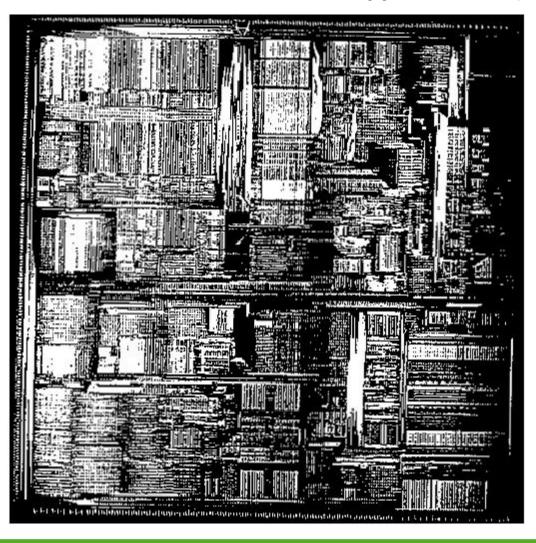
工艺: 0.35/0.25 um

**CMOS** 

晶体管数:750万

时钟频率: 233~450

#### Moore定律(CPU的发展)



Intel Pentium III CPU

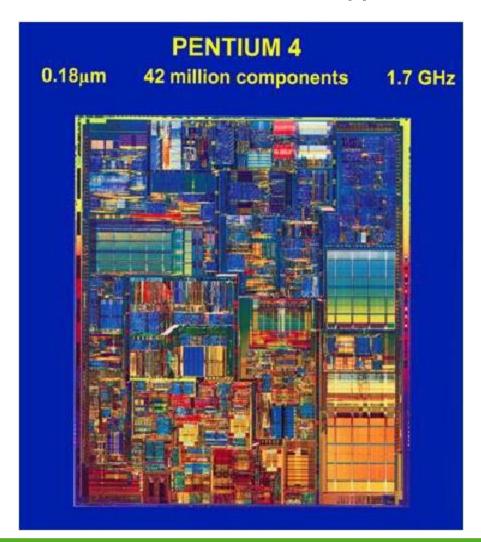
发布日期: 1999年2月

工艺: 0.18um CMOS

晶体管数: 2400万

时钟频率: 450~1000

#### Moore定律(CPU的发展)



发布时间: 2000年

11月

工艺:

0.18/0.13um CMOS

晶体管数: 4200万

时钟频率: 1.7 ~

3.06GHz

#### 结论:

- 1、功耗问题制约着集成电路的进一步发展
- 2、考虑到功耗问题,想要增大集成度就必须降低工作频率, 想要增加工作频率就必须降低集成度,因此两者之间存 在一个折中
- 3、22nm技术以下,需要新的材料和制造工艺来降低栅极和 沟道的电荷泄漏以及需要改变已有MOSFET的结构

